

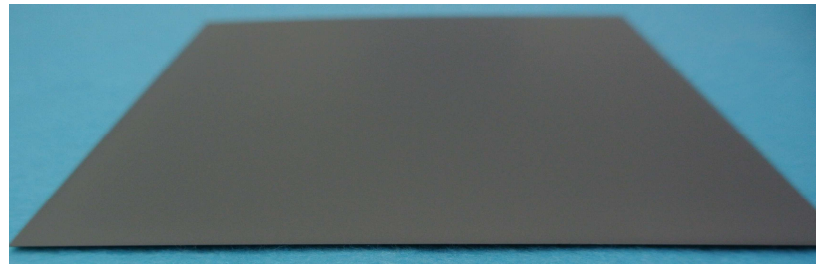


エンジニアリングセラミックス

Si₃N₄(Silicon Nitride) 基板

特徴

- Probe Card用 基板
- レーザー加工に最適
- HIP処理を施し、反りを低減。ポア30μm以下。
- 標準材；100角、150角 厚み；0.2～0.4mm
- 色；黒 平坦度；50μm



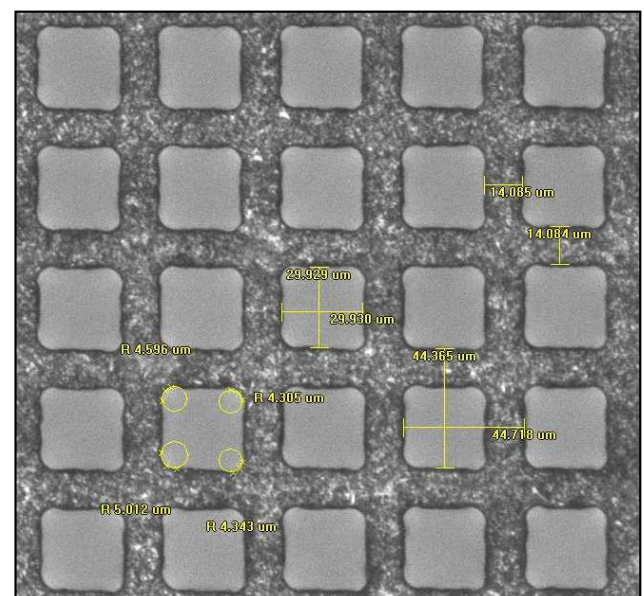
HIP Si₃N₄成分

HIP Si ₃ N ₄ 成分	
Al ₂ O ₃	<10%
Y ₂ O ₃	
Fe ₂ O ₃	<0.5%
CaO	<1.0%
MgO	
Na ₂ O	<0.1%
K ₂ O	
Si ₃ N ₄	>88%

物性

HIP Silicon Nitride

				HIP
Density		g/cm ³		3.26
Water Absorption		%		0
Mechanical Characteristics	Vickers Hardness (Load 5KG)	Gpa		15
	Flexural Strength	Mpa		1000
	Compressive Strength	Mpa		3900
	Young's Modulus of Elasticity	Gpa		310
	Poisson's Ratio	-		0.28
Fracture Toughness		Mpa·m ^{1/2}		7
Thermal Characteristics	Coefficient of Thermal Expansion	40-400	*10-6/°C	2.5
	Thermal Conductivity	20 °C	W(m·K)	23
Electrical Characteristics	Volume Resistivity	20 °C	Ω·cm	≥10 ¹⁴
	Dielectric Constant (1MHz)	-		-



ラックデザイン株式会社

TEL; 0944-85-9536

E-mail; info@luckdesign.jp